


	<h2>SI7892BDP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7892BDP-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7892BDP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4610 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7892BDP-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	4610 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 15A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3775pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7892BDP-T1-GE3TR

SI7892BDP-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI7892BDP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7892BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7892BDP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7892DP-T1-E3</b> VISHAT SI7892DP-T1-E3 VISHAT</p>	 <p><b>SI7892ADP-T1-GE3</b> V SI7892ADP-T1-GE3 V</p>	 <p><b>SI7892ADP-T1-E3</b> VISHAY SI7892ADP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7892BDP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7892BDP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7892ADP-T1-GE3.</b> VIS SI7892ADP-T1-GE3. VIS</p>	 <p><b>SI7892BDP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7892DP</b> VISHAY SI7892DP VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI7882DP-T1-GE3	 SI7884BDP	 SI7884BDP-T1-E3	 SI7884BDP-T1-E3	 SI7884BDP-T1-GE3
 SI7884BDP-T1-GE3	 SI7884DP-T1-E3	 SI7884DP-T1-GE3	 SI7886ADP-T1-E3	 SI7886ADP-T1-E3
 SI7886ADP-T1-GE3	 SI7886ADP-T1-GE3	 SI7886DP	 SI7886DP-T1	 SI7886DP-T1-E3
 SI7886DP-T1-GE3	 SI7888DP-T1-E3	 SI7888DP-T1-E3	 SI7888DP-T1-GE3	 SI7888DP-T1-GE3
 SI7892ADP-T1-E3	 SI7892ADP-T1-GE3	 SI7892ADP-T1-GE3.	 SI7892BDP-T1-E3	 SI7892BDP-T1-E3
 SI7892BDP-T1-GE3	 SI7892DP	 SI7892DP-T1	 SI7892DP-T1-E3	 SI7892DP-T1-GE3
 SI7898DP	 SI7898DP-T1-E3	 SI7898DP-T1-E3	 SI7898DP-T1-GE3	 SI7898DP-T1-GE3
 SI7900ADN	 SI7900AEDN	 SI7900AEDN-T1	 SI7900AEDN-T1-E3	 SI7900AEDN-T1-E3
 SI7900AEDN-T1-GE3	 SI7900AEDN-T1-GE3	 SI7900EDN	 SI7900EDN-T1	 SI7900EDN-T1-E3
 SI7900EDN-T1-GE3	 SI7901EDN-T1	 SI7901EDN-T1-E3	 SI7901EDN-T1-E3	 SI7904BDN-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

